Previous Doc

Next Doc First Hit

a∞1-1

Go to Doc#

Generate Collection

L6: Entry 16 of 98

File: JPAB

Jun 22, 2001

PUB-NO: JP02001168672A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001168672 A TITLE: SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

PUBN-DATE: June 22, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

<u>IKE</u>DA, KAZUO SEKI, SHUNICHI TSUNEKAWA, AKIO

MITA, NARUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP11348452

APPL-DATE: December 8, 1999

INT-CL (IPC): $\underline{H03}$ \underline{H} $\underline{9/145}$; $\underline{H03}$ \underline{H} $\underline{9/25}$; $\underline{H03}$ \underline{H} $\underline{9/64}$

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a <u>surface acoustic wave</u> device capable of preventing electrode breakage between IDT electrodes and between the IDT electrodes and reflector electrodes.

SOLUTION: On a piezoelectric substrate 10, a <u>surface acoustic wave</u> resonator having the IDT electrodes 11 and 12 and the reflector electrodes 13 and 14 provided on both sides of them are formed and a <u>capacitive</u> electrode 15 is formed. This <u>surface acoustic wave</u> resonator is connected in <u>series</u> between input and output terminals 16 and 17, and the electrode 15 is connected in <u>parallel</u> between the terminals 16 and 17. The electrode 15 is liable to leak-discharge more easily between the transducer fingers of the electrodes 11 and 12 than between the electrodes 11, 12 and the electrodes 13, 14.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特期2001-168672

(P2001-168672A)

(43)公開日 平成13年6月22日(2001.6.22)

| (51) Int.Cl. ⁷ | | 識別記号 | FΙ | | Ť | -7]-ド(参考) |
|---------------------------|-------|------|------|-------|---|-----------|
| H03H | 9/145 | | H03H | 9/145 | D | 5 J O 9 7 |
| | 9/25 | | | 9/25 | Α | |
| | 9/64 | | | 9/64 | Z | |

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

| (21)出顧番号 | 特顯平11-348452 | (71) 出顧人 000005821 | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | 松下電器産業株式会社 | | |
| (22)出顧日 | 平成11年12月8日(1999.12.8) | 大阪府門真市大字門真1006番地 | | |
| | | (72)発明者 池田 和生 | | |
| | | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 | | |
| | | 産業株式会社内 | | |
| | | (72)発明者 関 俊一 | | |
| | | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 | | |
| | | 産業株式会社内 | | |
| | | (74)代理人 100097445 | | |
| | | 弁理士 岩橋 文雄 (外2名) | | |
| | | | | |
| | | · | | |
| | | 最終頁に続く | | |

(54)【発明の名称】 弾性表面波デパイス

(57)【要約】

【課題】 IDT電極間及びIDT電極と反射器電極間の電極破壊を防止することのできる弾性表面波デバイスを提供することを目的とする。

【解決手段】 圧電基板10上にIDT電極11,12 とこの両側に設けた反射器電極13,14とを有する弾性表面波共振器を形成するとともに、容量性電極15を形成する。この弾性表面波共振器は入、出力端子16,17間直列に接続するとともに、容量性電極15は入、出力端子16,17間に並列に接続する。また容量性電極15はIDT電極11,12の電極指間及びIDT電極11,12と反射器電極13,14間よりもリーク放電しやすいものである。

10 圧電基板

11,12 IDT電極

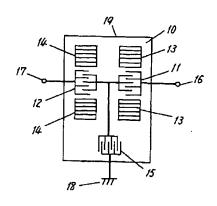
13.14 反射器電極

15 容量性電極

76 入力端子

17 出力端子

18 アース端子



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板と、この圧電基板上に設けた 入、出力端子と、この入、出力端子間に設けた弾性表面 波共振器と、前記入、出力端子間に並列に接続した容量 性電極とを備え、前記弾性表面波共振器はインターディ ジタルトランスデューサー電極とこの両側に設けた反射 器電極とを有し、前記容量性電極は前記インターディジ タルトランスデューサー電極間及び前記インターディジ タルトランスデューサー電極と前記反射器電極間よりも リーク放電しやすいものである弾性表面波デバイス。 【請求項2】 容量性電極は少なくとも一個所の鋭利な 突起部を有する請求項1に記載の弾性表面波デバイス。 【請求項3】 容量性電極はすだれ状電極であり、その 少なくとも一部の櫛電極間隔をインターディジタルトラ ンスデューサー電極の櫛電極間隔及び前記インターディ ジタルトランスデューサー電極と反射器電極との間隔よ りも狭くした請求項1に記載の弾性表面波デバイス。

【請求項4】 インターディジタルトランスデューサー 電極の表面は絶縁層で覆われている請求項1に記載の弾 性表面波デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインターディジタルトランスデューサー電極(以下IDT電極とする)間あるいはIDT電極と反射器電極間で起こる焦電破壊を抑制する弾性表面波デバイスに間するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の弾性表面波デバイスは、図4に示すように圧電基板100上にIDT電101とこの両側に設けた反射器電極102とを有する弾性表面波共振器 30を入、出力端子103,104間に設けたものであった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】この構成によると急激な温度変化に曝されると圧電基板100が分極し、ID T電極101や反射器電極102に蓄積される電荷量が 異なることによりIDT電極101間、IDT電極10 1と反射器電極102間に電位差が生じ、間隔の狭いと ころでリーク放電し、電極破壊を生じるという問題点を 有していた。

【0004】そこで本発明は、IDT電極間及びIDT電極と反射器電極間の電極破壊を防止することのできる弾性表面波デバイスを提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明の弾性表面波デバイスは、圧電基板と、この圧電基板上に設けた入、出力端子と、この入、出力端子間に設けた弾性表面波共振器と、前記入、出力端子間に並列に接続した容量性電極とを備え、前記弾性表面波共振 50

器はIDT電極とこの両側に設けた反射器電極とを有し、前記容量性電極は前記IDT電極間及び前記IDT電極と前記反射器電極間よりもリーク放電しやすいものであり、容量性電極で電荷を放電させることにより、電極破壊を防止することができる。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、圧電基板と、この圧電基板上に設けた入、出力端子と、この入、出力端子間に設けた弾性表面波共振器と、前記入、出力端子間に並列に接続した容量性電極とを備え、前記弾性表面波共振器はIDT電極とこの両側に設けた反射器電極とを有し、前記容量性電極は前記IDT電極間及び前記IDT電極と前記反射器電極間よりもリーク放電しやすい弾性表面波デバイスであり、急激な温度変化により電位差が生じた場合、容量性電極でリーク放電させることにより、IDT電極及び反射器電極の焦電破壊を防止することができる。

【0007】請求項2に記載の発明は、容量性電極は少なくとも一個所の鋭利な突起部を有する請求項1に記載20 の弾性表面波デバイスであり、容量性電極でリーク放電をしやすいものである。

【0008】請求項3に記載の発明は、容量性電極はすだれ状電極であり、その少なくとも一部の櫛電極間隔をIDT電極と反射器電極との間隔よりも狭くした請求項1に記載の弾性表面波デバイスであり、容量性電極でリーク放電しやすいものである。

【0009】請求項4に記載の発明は、IDT電極の表面は絶縁層で覆われている請求項1に記載の弾性表面波デバイスであり、IDT電極の焦電破壊を防止することができるものである。

【 0 0 1 0 】以下本発明の実施の形態について図面を参 照しながら説明する。

【0011】(実施の形態1)図1は本発明の実施の形態1における弾性表面波デバイスの上面図であり、10は圧電基板、11,12はIDT電極、13,14は反射器電極、15は容量性電極、16は入力端子、17は出力端子、18はアース端子、19は弾性表面波デバイスである。

40 【0012】圧電基板10はLiTaO3又はLiNbO3などの単結晶を用いて形成したものであり、IDT電極11,12、反射器電極13,14、容量性電極15はAlまたはAl-Cu合金を用いて形成したものである。

【0013】また、IDT電極11とこの両側に設けた 反射器電極13、IDT電極12とこの両側に設けた反 射器電極14でそれぞれ弾性表面波共振器を形成してい る。

【0014】入、出力端子16,17間に二つの弾性表面波共振器を直列に接続するとともに、入、出力端子1

WEST

3

6,17間に弾性表面波デバイス19の通過帯域周波数 に悪影響を及ぼさない程度の容量性電極 15の一端を並 列接続する。本実施の形態1において容量性電極15は 0.1pF以下の容量を有するものである。また、容量 性電極15の他端はアース端子18に接続している。

【0015】さらに容量性電極15はすだれ状電極であ り、少なくとも一部の櫛電極間隔が I D T電極11,1 2の櫛電極間隔及びIDT電極11,12と反射器電極 13,14との間隔よりも狭くした構造となっている。 【0016】この弾性表面波デバイス19に急激な温度 10 変化が生じて圧電基板10に焦電効果による電荷が発生 すると、容量性電極15の櫛電極間隔の狭いところでリ ーク放電することとなる。従ってIDT電極11,12 間及びIDT電極11,12と反射器電極13,14間 でのリーク放電を防止し、弾性表面波デバイス19の特 性が変化するのを防止することができる。

【0017】(実施の形態2)図2は本発明の実施の形 態2における弾性表面波デバイスの上面図であり、容量 性電極25は先端が鋭利な突起25a, 25bを対向さ せてスパークギャップを形成したものである。

【0018】本実施の形態2の弾性表面波デバイスは、 図1に示す弾性表面波デバイスの容量性電極15を図2 に示す容量性電極25で置き換えたものであり、他の構 成は実施の形態1で説明した通りであり、同番号を付し て説明を省略する。

【0019】この弾性表面波デバイスの容量性電極25 においては、対向する突起25a, 25b間の最も短い 部分の距離をIDT電極11、12の櫛電極間隔及びI DT電極11,12と反射器電極13,14の間隔より も短くしたものである。

【0020】この弾性表面波デバイス19に急激な温度 変化が生じて圧電基板10に焦電効果による電荷が発生 すると、容量性電極25の突起25a, 25b間隔の狭 いところでリーク放電することとなる。従ってIDT電 極11,12間及びIDT電極11,12と反射器電極 13,14間でのリーク放電を防止し、弾性表面波デバ イス19の特性が変化するのを防止することができる。

【0021】なお、本実施の形態2においては突起25 a, 25bを対向させるように設けたが、対向する電極 の一方のみに先端が鋭利な突起を設けても同様の効果が 40 得られるが、先端が鋭利な突起25a, 25bを対向さ せるようにすることにより、さらにこの部分でリーク放 雷させやすくなる。

【0022】(実施の形態3)図3は本発明の実施の形 態3における弾性表面波デバイスの上面図であり、図1 と同じ構成要素については同番号を付して説明を省略す

【0023】本実施の形態3の弾性表面波デバイスの図 1に示す弾性表面波デバイスと異なる点は、少なくとも IDT電極11,12の表面を陽極酸化することにより 50 14 反射器電極

絶縁層20で被覆した点である。もちろん反射器電極1

3,14の表面にも絶縁層を設けても構わない。 【0024】この弾性表面波デバイス19において、急 激な温度変化が生じて圧電基板10に焦電効果による電

荷が発生すると、IDT電極11,12の表面が絶縁層 20で覆われているため、空気中への放電が妨げられ電 荷が蓄積される。その結果、表面を絶縁層20で被覆し ていない容量性電極15の櫛電極間隔の狭いところでリ ーク放電することとなる。従って I D T電極 1 1 . 1 2 間及びIDT電極11,12と反射器電極13,14間 でのリーク放電を防止し、弾性表面波デバイス19の特

【0025】なお、本実施の形態3において容量性電極 15は図1に示すようなすだれ状電極としたが、図2に 示すように先端が鋭利な突起を対向させた電極とするこ とにより、さらに容量性電極15でリーク放電しやすく なる。

性が変化するのを防止することができる。

【0026】なお、上記実施の形態1~3においては、 入、出力端子16,17間に二つの弾性表面波共振器を 直列に接続したが、少なくとも一つの弾性表面波共振器 を入、出力端子16,17間に直列または並列に接続 し、入、出力端子16,17間に並列に弾性表面波デバ イス19の周波数特性に影響を及ぼさない程度の容量性 電極15,25を接続した弾性表面波デバイス19にお いては同様の効果が得られる。

【0027】また、容量性電極15,25は、リーク放 電したときショート状態になると弾性表面波デバイス1 9の特性に悪影響を及ぼす。例えばフィルタの場合では 挿入損失が大きくなる。したがってリーク放電したとき 30 にショート状態とならないような形状とすることが好ま LW.

[0028]

【発明の効果】以上本発明によれば、急激な温度変化に より電位差が生じた場合、容量性電極でリーク放電させ ることにより、IDT電極及び反射器電極の焦電破壊を 防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における弾性表面波デバ イスの上面図

【図2】本発明の実施の形態2における弾性表面波デバ イスの上面図

【図3】本発明の実施の形態3における弾性表面波デバ イスの上面図

【図4】従来の弾性表面波デバイスの上面図 【符号の説明】

- 10 圧電基板
- 11 IDT電極
- 12 IDT電極
- 13 反射器電極

WEST

5

- 15 容量性電極
- 16 入力端子
- 17 出力端子
- 18 アース端子
- 19 弾性表面波デバイス

20 絶縁層

25 容量性電極

25a 突起

25b 突起

【図1】

10 圧電基板

11.12 IDT電極

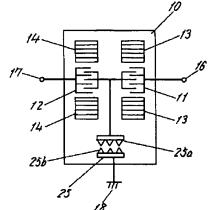
13,14 反射器電極

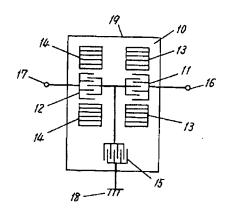
15 容量性電極

16 入力端子 17 出力端子

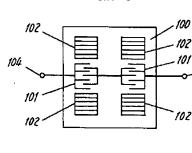
18 アース端子



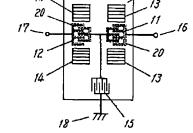




【図3】







フロントページの続き

(72)発明者 常川 昭雄

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 三田 成大

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

Fターム(参考) 5J097 AA27 BB02 BB11 CC02 DD21 DD29 FF03 HA02